



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

سمینار دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد

با عنوان

ساخت و مشخصه‌یابی نانوزنراتور تریبوالکتریک بر پایه نانومواد دو بعدی  $\text{MoS}_2$

Fabrication and Characterization of a Triboelectric Nanogenerator based on two-dimensional  $\text{MoS}_2$

ارائه دهنده: محمد امین جلیلی

مکان: سالن سمینار

زمان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰

اعضای کمیته داوری:

اساتید راهنما: دکتر فتح‌اله کریم‌زاده - دکتر محمد حسین عنایتی

اساتید داور: دکتر محمد حسن عباسی - دکتر مهران نحوی

چکیده:

با توجه به پیشرفت‌های اخیر صنعت الکترونیک، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بشر با آن روبه‌رو شده، تأمین انرژی مورد نیاز با روش‌های سازگار با محیط زیست است. در این میان، برداشت انرژی تلف شده محیط اطراف توسط نانوزنراتورهای تریبوالکتریک روشی به صرفه و مناسب به نظر می‌رسد. این نانوزنراتور برای تولید انرژی در مقیاس نانو و میکرو، حسگر خودران، انرژی آبی و تولید انرژی در مقیاس بزرگ کاربرد دارد. در کنار تمام مزیت‌های نانوزنراتور تریبوالکتریک، این فناوری جدید با مشکلاتی همچون توان پایین، سایش لایه‌های تریبوالکتریک، دوام کم، ترکیب بارها، ناپایداری، محافظت از لایه‌ها و مشکلات تولید صنعتی نانوزنراتور اشاره کرد. برای حل این مشکلات تلاش‌های زیادی انجام شده است. در این بین، استفاده از نانوذرات دو بعدی همچون گرافن و مولیبدن دی‌سولفید می‌تواند با توجه به نسبت سطح به حجم بالا و اثرات محدودیت کوانتمی باعث قابلیت ذخیره بار حاصل از القای الکترواستاتیک بر روی نانوذرات دو بعدی شود و خروجی نانوزنراتور را تا چند برابر افزایش دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که عیوب ساختاری نانوصفحات مولیبدن دی‌سولفید باعث گیر انداختن الکترون می‌شود که از این قابلیت می‌توان برای جلوگیری از هدر رفتن بار در نانوزنراتورها استفاده کرد. در پژوهش پیش‌رو، نانوصفحات دو بعدی مولیبدن دی‌سولفید از طریق روش لایه‌برداری فاز مایع با استفاده از حمام آلتراسونیک و پروب آلتراسونیک انجام شد و نانوصفحات دو بعدی حاصل دارای ابعاد حدود ۱۰۰ نانومتر و گاف انرژی ۱/۷۲ الکترون ولت بود. لایه‌نشانی‌ها برای تولید نانوزنراتور از طریق پوششدهی چرخشی انجام شد. ضخامت لایه‌های نانوزنراتور بهینه‌سازی شد و نانوزنراتور بهینه دارای لایه منفی دو گانه از جنس کامپوزیت پلی‌استایرن و  $\text{MoS}_2$  با درصد وزنی ۰/۰۲ درصد و لایه پلی‌استایرن بود که لایه پلیمری به عنوان لایه تماسی و لایه کامپوزیتی به عنوان لایه جاذب الکترون کاربرد داشت. در سمت مثبت نانوزنراتور از صمغ دانه گیاه قدومه استفاده شد و غلظت این لایه مثبت بهینه‌سازی شد. نانوزنراتور حاصل تحت شرایط بهینه ۸ نیوتون و فرکانس ۴/۵ هرتز دارای ولتاژ مدار باز ۱۲۰۵ ولت و جریان ۰/۷۴ میلی آمپر بود. به علاوه توان این نانوزنراتور ۱۱/۲۷ میلی وات بود. مطابق انتظارات این نانوزنراتور توانایی روشن کردن ۱۱۵ لامپ LED را داشت و توانست به راحتی در زمان ۲۰ ثانیه یک خازن ۱ میکروفاراد را شارژ کند. در ادامه تحقیق شبیه‌سازی نانوزنراتور تریبوالکتریک انجام شد. برای نشان دادن کاربرد وسیع نانوزنراتورها در این پژوهش از نانوزنراتور ساخته شده برای اولین بار با هدف اتصال نانومیله‌های نقره استفاده شد. نانومیله‌های نقره با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون، اتیلن گلیکول و آهن (III) کلرید شش آب و نقره نترات سنتز شد و با استفاده از یک سیستم طراحی شده برای متصل کردن دو الکتروود به نانوزنراتور فرایند اتصال نانومیله‌ها انجام شد.

کلمات کلیدی

نانوزنراتور، نانوزنراتور تریبوالکتریک، نانوصفحات دو بعدی، مولیبدن دی‌سولفید، توان